

斬新なレーザと高効率のLEDの実現を可能にするフォトニック結晶

野田 康

2次元(2D)フォトニック結晶は完全な單一モードレーザの実現を可能にする。また、2Dフォトニック結晶のバンドギャップは自然放熱を制御して光エネルギーを垂直方向へ直接放射を可能とするため、LEDへの応用可能性も検索されている。

結晶半導体が逐次的に変化するフォトニック結晶は、光子マニピュレーションの新しい手段を与える画期的な材料だ。2Dフォトニック結晶は広い面積でも完全な單一モードで動作する全く新しい半導体レーザの基礎になるが、レーザ発振の原理は2Dフォトニック結晶を種々の方向に伝播する光波のモードレンジ結合に基づいている。

一方、面内で2D方向に散射される自然放熱は2Dバンドギャップ効果によって抑制される。同時に、蓄積されたエネルギーはバンドギャップ効果が存在しない垂直方向に再分配する。その結果、2Dフォトニック結晶の内部では自然放熱の抑制と再分配が同時に可能になり、非常に高い外部散熱分離効率をもつ発光ダイオード(LED)への応用という極めて大きな可能性が生まれる。

レーザ発振の側面

一般的に、半導体レーザの面積が広くなると横モードは多モードになり、その動作は非常に不安定になる。しかし、大面積半導体レーザの場合でも安定な單一モードおよび横モードの発振を達成できれば、まったく新しいレーザを実現できる。現在では、このようなレーザの作動が2Dフォトニック結晶を用いることで可能になりつつある。

2Dフォトニックレーザの場合、結晶構造は利得確実なわち活性層の上部

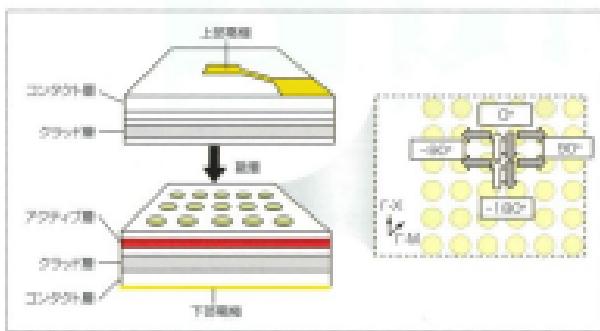


図1 2Dフォトニック結晶レーザは、フォトニック結晶格子を上面にもつアクティブラインと上面コンタクト層、クラッド層を組合して構成する。光路は四つの方向に伝播して2D電流を形成する。

に形成され、デバイスの内部に埋め込まれる(図1)。フォトニック結晶は正方形格子構造であり、一つの丁字の格子周期は活性層の発光範囲と一致するように設計されている。この場合、この方向に伝播する光波は、後方(-180°)ばかりでなく(二つの直角方向±90°)にも反射され、四つの等価な丁字方向に伝播する光波間の光結合を引き起こして、2D電流池(または2D共振器モード)を生成する。このレーザのバンド圖での共振器モードは見の構造がゼロに近いパンド層で生じる¹⁾。2Dフォトニック結晶はウエハに対して垂直方向の結晶格子としても機能するため、このデバイスは面発光動作する。

作製した約0.1~1000nmの発振波長を

もつInGaAs/AlGaAsフォトニック結晶レーザで理論計算したバンド圖は測定により得られたバンド圖とよく一致した。レーザ発振の基底は1250×1500nmの広い面積だったが、パワー自力、レーザ発振スペクトル、近視野と遠視野のパタンは、いずれも安定な單一モード発振が良好に実現されたことを示した(図2)。デバイスに垂直な方向の遠視野パタンはスニーカーをリング形状のビームパタンに作った。このパタンは上述したバンド圖のレーザ発振モードの電場強度分布によって生じる。このパタンは不透明物体のマニピュレーションを行なう光ビンセットの開発にとつて重要ななると考えられる。最近の研究では、結晶中の半導体格子および格子

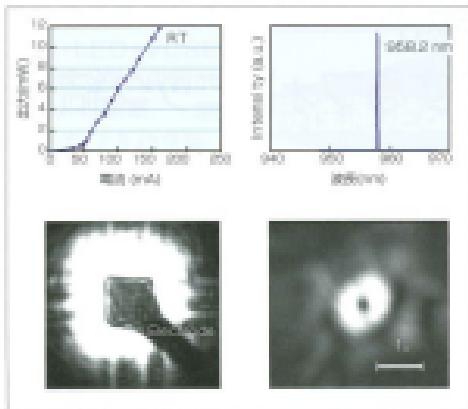


図2 電場-光強度特性(上左)、强度スペクトル(上右)および電場強度(下左)は、2Dフォトニクス結晶レーザが電場強度の大さいが、実験室に第一回の動作をしていることを示している。アバイスに対して電場方向の電場強度(下右)はピーク波長1'の映し出された各波長をもつ。このユニークなリング形状には共振ビンセットへの応用の可能性がある。

使用のマニピュレーションによって、ビームパッケンの形状制御が可能になります。

自然放出の制御

自然放出自はフォトニクスデバイスの性能を制限する基本的な要因(ボトルネック)だ。例えばLEDの場合、デバイスから取り出せない自然放出自は損失の原因になる。同様に、レーザの場合も、レーザ発振モードに結合しない自然放出自は損失と騒音の両方をもたらす。従って、簡便でない自然放出自の抑制と利用可能な形へのエネルギーの再配分が非常に重要な。われわれは、2Dフォトニクス結晶を用いると、結晶内部に埋め込まれた発光体からの2D面内方向への自然放出自が抑制されることを実証した。同時に、発光体に抑制されるエネルギーが垂直方向に再配分されることも確認した。

自然放出自は直角場の極小値から発生する。自然放出自合(R_{out})はフェルミの平衡状態で与えられ、光学モードの数によって決まる。この光学モードを何らかの方法で操作することにより、自

然放出自の制御が可能になる。

この効果を実証するために、GaNAsP半導体スラブの三角格子2Dフォトニクス結晶を作製した(図3)。この単一量子井戸(縮短)を発光材料にした構造は、四面体モーメントの方向がスラブ面に平行なTE偏光の光を発生する。薄いスラブ中の光学モードは二つのモード、すなわち、垂直方向への全内部反射(TIR)の条件が満足されて2D面内に閉じ込められる「スラブモード」と、

スラブモードへの発光は2Dフォトニクス結晶のバンドギャップによって抑制されるため、QWから放射される光子は垂直モードのみと結合し、垂直方向への自然放出自の量子効率は増加する。これらの同時効果、すなわち、2Dスラブモードへの自然放出自の抑制によるR_{out}の減少と垂直モードの発光効率の増加は、2D面内から垂直方向へのエネルギーの一回配分において、2Dフォトニクス結晶が重要な役割を果たしていることを示す。

他の垂直方向への再配分効果は詳細な実験によって実証された。実験では周期が300-500nm、間隔が10nmのフォトニクス結晶格子の同一ウェーハ上に製作された一連の試料が使用された。これらの試料の共振ピンцинがTi:Al₂O₃レーザからの波長380nm、バルス幅2ps、強度は2MHzのパルスを使用して温度4Kで行なわれた。電

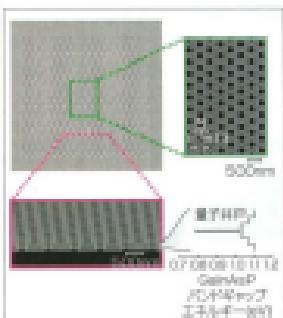


図3 自然放出自は単一量子井戸(縮短)をもつ2Dフォトニクス結晶スラブによって抑制される。

光波長がアトニッカバンドギャップの範囲内にあるときの自然放電の寿命 (t_1/R_{ex} に対応する) は、アトニッカバンドギャップを用いた場合に比べて 5 倍に増加した(図4)。一方、発光器具がアトニッカバンドギャップの範囲外にあると、垂直方向への自然放電の寿命と発光効率はいずれもアトニッカバンドギャップのない構造での結果と同等であった。これらの結果は理論解析の結果とよく一致し、自然放電の抑制と再配分が 2D アトニッカバンドによって同時に可能になることを十分に実証している。

この実験は非反射再結合過程を防ぐために低温で行なわれたが、例えば電子ナノ構造による 3D キャリヤ界面に沿った効率を利用すれば、この効率は室温でも可能だ。2D アトニッカバンドで実現された自然放電の制御はアトニッカデバイスの発展に際して重要なステップになる。特に、次世代の全周光照明システムとして非常に重要な LED の均熱分布効率が大幅に向かうだろう。

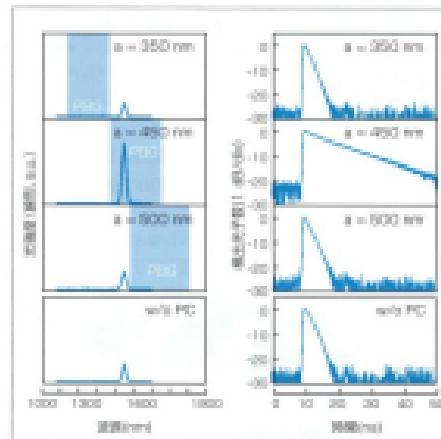


図4 レーザ発光器具が 2D 構造のアトニッカバンドギャップ構造の内部にあるとき(3D 構造の電子定数 μ が 450 nm のとき)、波長を開始にした光強度(左)および実現する時間は発光光束率(右)は、アトニッカバンドギャップを有しない構造で得られるものと異なる。

参考文献

- (1) M. Imada et al., *Appl. Phys. Lett.* 75, 318 (1999).
- (2) S. Noda et al., *Science* 285, 1123 (2000).
- (3) D. Okada et al., *Optics Express* 12, 1583 (2004).
- (4) E. Saito et al., *IEEE J. Selected Areas in Communications* 23, 1238 (2005).
- (5) M. Fujii et al., *Science* 308, 1296 (2005).

著者紹介

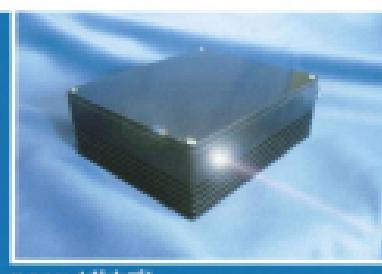
野田英史は京都大学電子工学研究所の教授。

E-mail: noda@kuee.kyoto-u.ac.jp

本記事は *Laser Focus World* 2005年12月号に掲載された英文記事の翻訳転載です。

144

MEGAOPTO 連続波紫外レーザー Series 120



株式会社メガオプト

〒241-0114 静岡県掛川市南郷71-64
phone: 054-449-0337 fax: 054-449-0332
<http://www.megaopto.co.jp> postmaster@megaopto.co.jp

現代的な検査器に「組み込み」可能な 初めてのUVレーザー、できました

皆様ならびに皆様へお光をフットプリントわずかに幅のサイズから始められます。基本構造を更にし、動作の安定性、ノイズの抑制を確実化しました。

専用内部の接続端子 TTL 18引脚をも。

■構造の特徴

レーザーは、半導体振動子のための特殊設計の光学設計で、これまでのUVレーザーでは実現不可能な大きさになりました。レーザー駆動回路や電気回路を内蔵するため、レーザーの操作に非常に簡単な構造を実現できています。

■ドライの特徴

開発段階で実験室にて構成するレーザーは、他の構造と全く同じ構成のUV140は既に量産段階にあります。また、コンパクトな構造により、実験室での操作性を考慮して、ドライの構成は、本製品の部品への組み込みを考慮して、ドライの構成です。

構成	ドライ	UV140
ドライ	ドライ	ドライ
半導体振動子	ドライ	ドライ
高輝度UVレーザー頭部	ドライ	ドライ
電源	ドライ	ドライ
ドライのUVレーザーの組み込み	ドライ	ドライ

構成	ドライ	UV140
電源	電源	電源
電源	電源	電源